

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

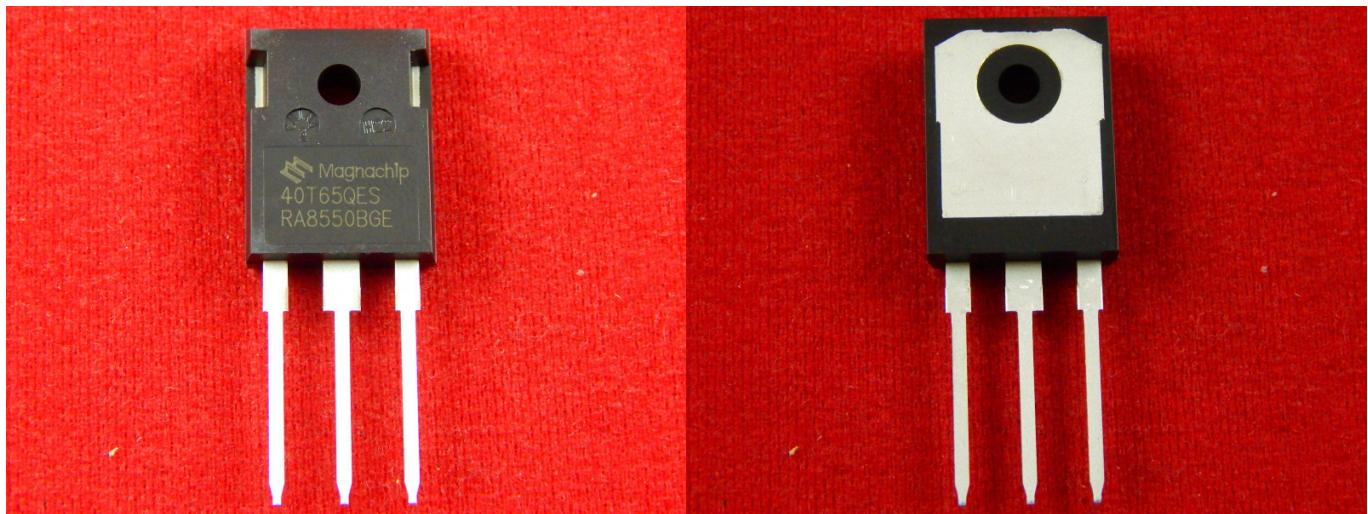
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17811

Цена в прайсе: 1078 тг.

MBQ40T65QES, Транзистор IGBT, N-канал, 650В, 80А, ТО-247



Транзистор – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

IGBT транзистор - это довольно хитроумный прибор, который представляет собой гибрид полевого и биполярного транзистора. Данное сочетание привело к тому, что он унаследовал положительные качества, как полевого транзистора, так и биполярного.

Спецификация:

- Тип транзистора: IGBT;
- Маркировка: 40T65QES;
- Тип управляющего канала: N;
- Максимальная рассеиваемая мощность (P_c), Вт: 230;
- Предельно-допустимое напряжение коллектор-эмиттер $|V_{ce}|$, В: 650;
- Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор $|V_{ge}|$, В: 20;
- Максимальный постоянный ток коллектора $|I_c| @25^\circ\text{C}$, А: 80;
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер типовое $|V_{CE(\text{sat})}|$, В: 1.8;
- Максимальное пороговое напряжение затвор-эмиттер $|V_{GE(\text{th})}|$, В: 6.5;
- Максимальная температура перехода (T_j), $^\circ\text{C}$: 150;
- Время нарастания типовое (tr), нС: 36;
- Емкость коллектора типовая (C_c), пФ: 120;
- Общий заряд затвора (Q_g), typ, нК: 60;
- Тип корпуса: ТО247.